

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年12月19日(19.12.2024)



(10) 国際公開番号

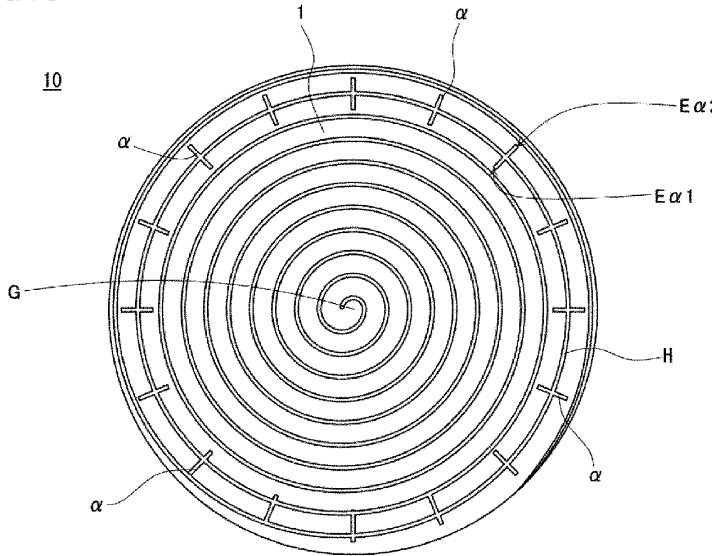
WO 2024/257742 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/26 (2012.01) H01L 21/304 (2006.01)
B24B 37/32 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/021113
- (22) 国際出願日: 2024年6月11日(11.06.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-096439 2023年6月12日(12.06.2023) JP
- (71) 出願人: 株式会社クラレ(KURARAY CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒7100801 岡山県倉敷市酒津 1 6
2 1 番地 Okayama (JP).
- (72) 発明者: 砂山 梓紗 (SUNAYAMA Azusa);
〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島 7 4 7 1 番
地 株式会社クラレ内 Okayama (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人大谷特許事務所(OHTANI
PATENT OFFICE); 〒1050001 東京都港区虎
ノ門三丁目25番2号 虎ノ門ES
ビル7階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,
EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG,
KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,
LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,

(54) Title: POLISHING PAD, POLISHING METHOD, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR

(54) 発明の名称: 研磨パッド、研磨方法及び半導体の製造方法

[図1]



(57) Abstract: The present invention relates to a polishing pad and a polishing method employing said polishing pad, the polishing pad including a polishing layer having a circular polishing surface, wherein: the polishing layer has one or more grooves α , each having a first end portion $E\alpha 1$ and a second end portion $E\alpha 2$ closer to the outer circumferential side of the polishing surface than the first end $E\alpha 1$, each groove α extending from the first end portion $E\alpha 1$ toward the second end portion $E\alpha 2$; the first end portion $E\alpha 1$ of each groove α exists in a region (1) which is in a range of 70.0 to 99.0% of the radius of the polishing surface from the center of the polishing surface; and the second end portion $E\alpha 2$ of each groove

[続葉有]

WO 2024/257742 A1

MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

α is not connected to the outer circumference of the polishing layer.

(57) 要約: 円形の研磨面を有する研磨層を含む研磨パッドであって、前記研磨層は、第一の端部 $E_{\alpha 1}$ と該第一の端部 $E_{\alpha 1}$ よりも前記研磨面の外周側にある第二の端部 $E_{\alpha 2}$ とを有する溝であって、前記第一の端部 $E_{\alpha 1}$ から前記第二の端部 $E_{\alpha 2}$ に向かって延びる溝 α を1本以上備え、前記溝 α の第一の端部 $E_{\alpha 1}$ が、前記研磨面の中心から前記研磨面の半径に対して70.0~99.0%の範囲である領域(1)内に存在し、前記溝 α の第二の端部 $E_{\alpha 2}$ が、前記研磨層の外周に接続していない、研磨パッド及び該研磨パッドを用いる研磨方法に関する。